



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **83447** (13) **U**
(51) МПК (2013.01)
A61Q 19/00
A61P 17/00

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2013 03759	(72) Винахідник(и): Козуб Павло Анатолійович (UA), Черніков Ігор Олександрович (UA), Ісаков Олексій Миколайович (UA), Козуб Світлана Миколаївна (UA), Чернікова Раїса Павлівна (UA)
(22) Дата подання заявки: 26.03.2013	
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.09.2013	
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 10.09.2013, Бюл.№ 17	(73) Власник(и): Козуб Павло Анатолійович, вул. Барнаульська, 27, м. Харків, 61013 (UA)

(54) СПОСІБ ОЧИСТКИ ШКІРИ

(57) Реферат:

Спосіб очистки шкіри полягає в тому, що процес проводять за допомогою очищеної води з кількістю домішок 0,1-5 ppm.

UA 83447 U

Корисна модель належить до косметичної та фармакологічної промисловості і медицини, а саме до способів покращення стану шкіри, методів запобігання зараженню, очистки та знежирення верхніх шарів шкіри.

Запропонований спосіб може бути використаний як самостійно, так і у сукупності з іншими косметичними засобами, які використовуються для очистки та знежирення шкіри.

Відомі на сьогоднішній день способи очистки шкіри та покращення її стану розчинами базуються на використанні різних хімічних речовин, які мають дезінфікуючу дію, є поверхнево-активними речовинами, або розчинниками забруднюючих шкіру речовин [1, 2].

Основними недоліками всіх перелічених способів є використання хімічних речовин, які незалежно від їх типу не є складовою частиною організму людини і тому є шкідливими реагентами для організму, особливо при їх постійному використанні, а також можуть викликати алергійні реакції та подразнення.

При фізико-механічних способах очищення [3, 4] (обробка скрапами, вакуумом, парою, кріоочистка) шкіра зазнає фізичних ушкоджень, що також негативно відбивається на загальному стані шкіри.

Таким чином, основні недоліки існуючих способів очистки шкіри є причиннообумовлені фізико-хімічними та біологічними процесами і не можуть бути усунуті простою зміною складу розчину для очистки або умовами процесу очистки.

В основу запропонованої корисної моделі поставлена задача створення способу очистки шкіри, без використання шкідливих речовин, має дезінфікуючі властивості та механічно не ушкоджує поверхню шкіри.

Поставлена задача вирішується тим, що очистка шкіри відбувається за допомогою очищеної від неорганічних та органічних речовин води з загальною кількістю домішок не більше 5 ppm.

Використання води з мінімальною кількістю домішок пояснюється її особливими властивостями, а саме великою розчинністю в такій воді майже всіх відомих неорганічних та органічних речовин, значним осмотичним тиском з на межі клітки та води, великою проникною спроможністю води у середину клітини та повною відсутністю токсичності по відношенню до організму.

За рахунок виникнення значного осмотичного тиску на межі клітин, глибоко очищена вода негативно діє на чужорідні біологічні об'єкти (віруси, бактерії, грибки, пухлини, виразки), що виражається в її дезінфікуючих властивостях.

Таким чином запропонований спосіб очистки шкіри за допомогою спеціально очищеної води дозволяє:

- проводити очистку поверхні шкіри від органічних та неорганічних забруднень одночасно;
- проводити очистку сальних залоз та міжклітинного простору;
- виводити токсичні речовини з шкіри та підшкірних шарів;
- зволожувати шкіру до необхідного для неї рівня вологості;
- дезінфікувати ушкодження шкіри;
- припиняти ріст пухлин та вогнищ зараження бактеріального, вірусного та грибкового характеру.

З проведених нами дослідів встановлено, що мінімальна кількість речовин у воді, при якій проявляються вказані вище властивості становить 5 ppm.

При більшій кількості солей або органічних речовин, розчинність забруднень у воді швидко зменшується і характер її дії відповідає звичайній пом'якшеній воді. При кількості домішок менше ніж 0,1 ppm корисні властивості води не підвищуються, тому більша очистка не є технологічно доцільною. Таким чином, оптимальна концентрація домішок у воді повинна становити 0,1-5 ppm.

Експериментально встановлено, що спосіб нанесення води на шкіру не має значення, але кількість води повинна відповідати шару води 0,2-0,5 мм, що відповідає 2-5 мл/дм².

Час витримки води на поверхні шкіри повинен бути достатнім для проведення процесу розчинення забруднень, руйнування чужорідних біологічних об'єктів та дифузії хімічних речовин з та в глибокі шари шкіри. Експериментально встановлено, що процес очищення без механічного впливу на верхні шари становить 20-40 с, а при додатковому механічному впливі (протирання, поглажування, масаж) може бути скорочений до 10-15 с.

Таким чином запропонований спосіб очистки може бути здійснено у такі способи:

Приклад 1.

Очищення шкіри обличчя відбувається нанесенням води за допомогою вмивання (руками, змоченим тампоном або губкою попередньо промитою очищеною водою), або розприскуванням з пульверизатора 10-15 мл очищеної води. Вода залишається на поверхні шкіри на 20-40 с, або

поверхня обличчя масується протягом 15-30 с. Після чого, поверхня протирається сухим рушником для повного видалення вологи.

Приклад 2.

5 Очищення шкіри в області пахв відбувається протирання змоченим тампоном або губкою попередньо промитими очищеною водою з кількістю води не менше 10-15 мл протягом 15-30 с. Після цього поверхня протирається сухим рушником для повного видалення вологи. При проведенні процедури 2 рази на день запах поту не відчувається протягом 24 годин.

Приклад 3.

10 Очищення шкіри в області декольте та грудей проводиться у вигляді накладення губки або тампону просочених очищеною водою (не менше 40 мл) на 60-120 с. Після чого поверхня шкіри протирається насухо чистим сухим рушником. При наявності у грудях пухлин, або ущільнень процедуру доцільно повторити 2-3 рази.

Джерела інформації:

1. Патент РФ № 2184531, опубл. 10.07.2002.
- 15 2. Патент України № 55878, опубл. 15.04.2003.
3. Патент України № 38682, опубл. 15.05.2001.
4. Патент РФ № 2463990, опубл. 20.10.2012.

20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Спосіб очистки шкіри, який полягає в тому, що процес проводять за допомогою очищеної води з кількістю домішок 0,1-5 ppm.

Комп'ютерна верстка Л. Литвиненко

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601